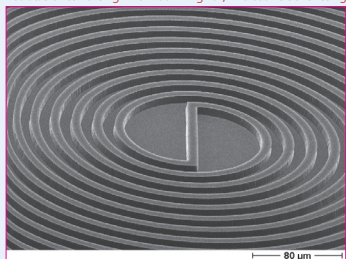


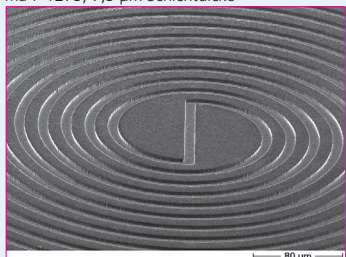
ma-P 1275 — Positiv-Photoresist

Hochaufbauender Resist für die UV-Lithographie

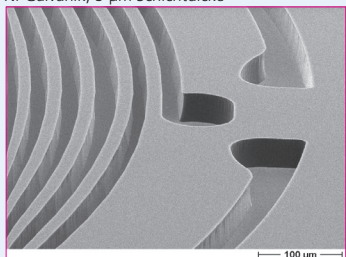
Resiststrukturierung mit Mask Aligner, Breitbandbelichtung



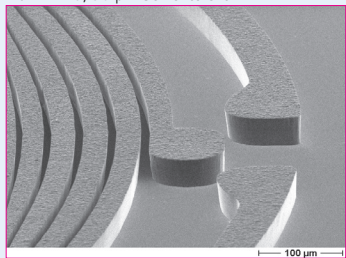
ma-P 1275, 7,5 µm Schichtdicke



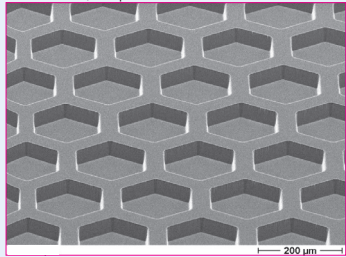
Ni-Galvanik, 5 µm Schichtdicke



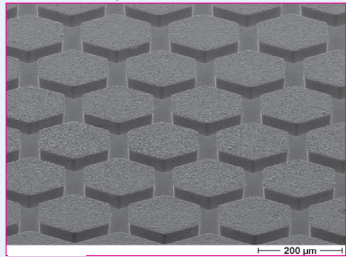
ma-P 1275, 30 µm Schichtdicke



Ni-Galvanik, 28 µm Schichtdicke



ma-P 1275, 40 µm Schichtdicke



Ni-Galvanik, 38 µm Schichtdicke

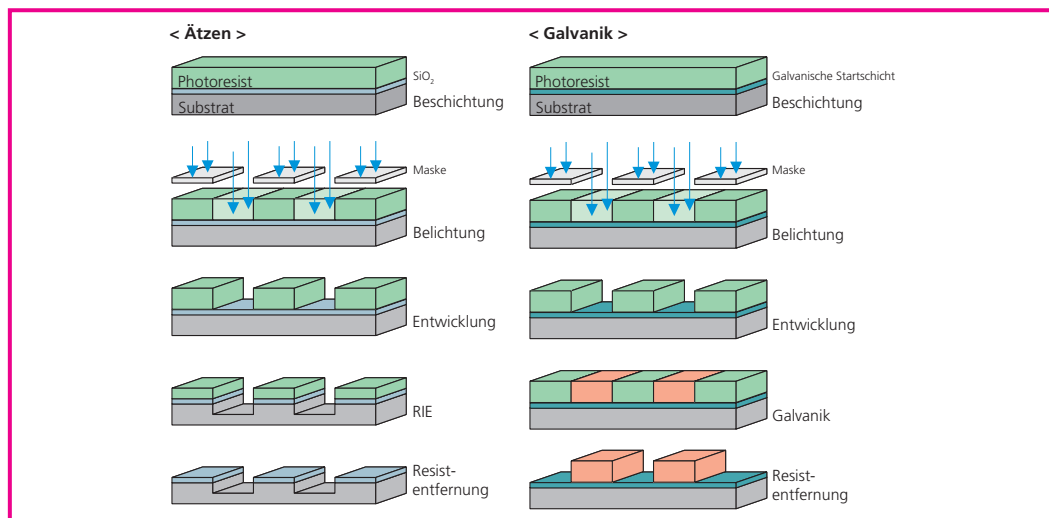
Wichtigste Merkmale

- Hervorragende Strukturstabilität in Nassätzprozessen und in sauren und alkalischen Galvanikbädern von pH 1 bis 13,5
- Hohe Trockenätzresistenz z.B. in CHF_3 , CF_4 , SF_6
- Wässrig-alkalische Entwicklung
- Leicht entfernbar
- Kantenwinkel bis 84°

Anwendungen

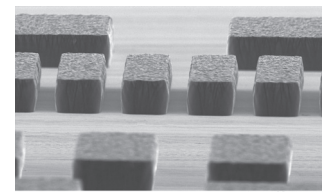
- Galvanikform, für z.B.
 - Mikrooptische Komponenten
 - Mikroschichten
 - Bumping
- Ätzmaske für z.B.
 - Si, SiO_2
 - Metalle
 - Halbleiter
- Maske für Ionenimplantation

Prozess-Schema



Technische Daten

Schichtdicke	µm	7,5	20	30	40
Schleuderbeschichtung	U min ⁻¹	3000	500	350	250
Schleuderzeit	s	30	90	90	90
Aspektverhältnis		3 - 4	3 - 4	3 - 4	3 - 4



Ni-Strukturen, 17 µm Schichtdicke

